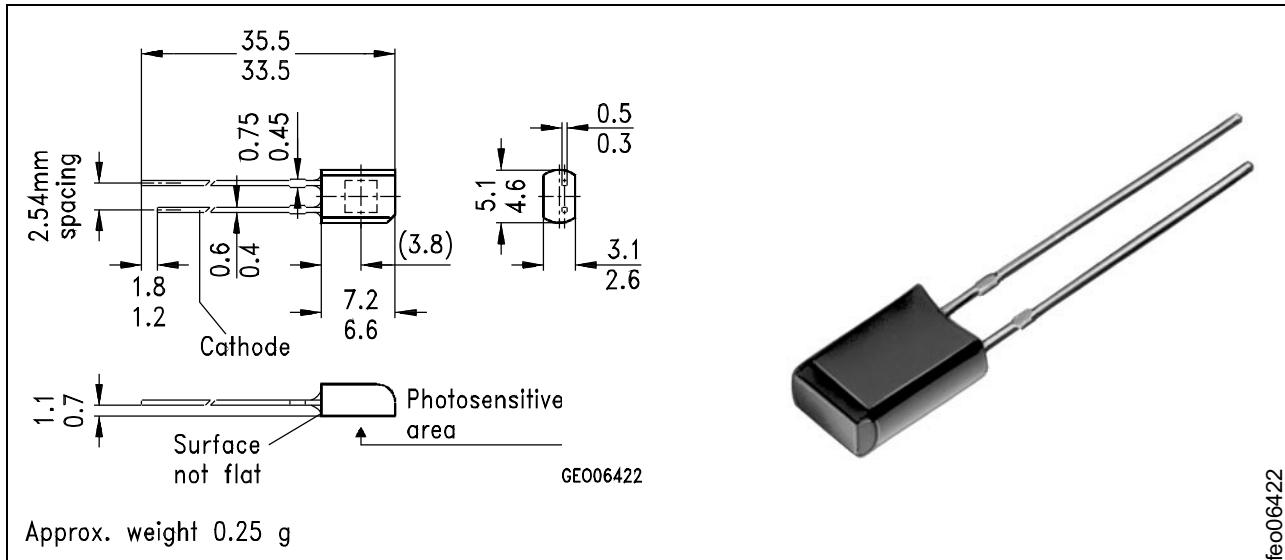


## Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter Silicon PIN Photodiode with Daylight Filter

SFH 235 FA



### Wesentliche Merkmale

- Speziell geeignet für Anwendungen bei 880 nm
- Kurze Schaltzeit (typ. 20 ns)
- 5 mm-Plastikbauform im LED-Gehäuse
- Auch gegurtet lieferbar

### Anwendungen

- IR-Fernsteuerung von Fernseh- und Rundfunkgeräten, Videorecordern, Lichtdimmern und Gerätefernsteuerungen
- Lichtschranken für Gleich- und Wechsellichtbetrieb

### Features

- Especially suitable for applications of 880 nm
- Short switching time (typ. 20 ns)
- 5 mm LED plastic package
- Also available on tape

### Applications

- IR-remote control of hi-fi and TV sets, video tape recorders, dimmers, remote control of various equipment
- Photointerrupters

Typ (*vorher) Type (*formerly)	Bestellnummer Ordering Code
SFH 235 FA (*SFH 235)	Q62702-P273

**Grenzwerte****Maximum Ratings**

<b>Bezeichnung</b> <b>Description</b>	<b>Symbol</b> <b>Symbol</b>	<b>Wert</b> <b>Value</b>	<b>Einheit</b> <b>Unit</b>
Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range	$T_{op}, T_{stg}$	- 40 ... + 80	°C
Löttemperatur (Lötstelle 2 mm vom Gehäuse entfernt bei Lötzeit $t \leq 3$ s) Soldering temperature in 2 mm distance from case bottom ( $t \leq 3$ s)	$T_s$	230	°C
Sperrspannung Reverse voltage	$V_R$	32	V
Verlustleistung, $T_A = 25$ °C Total power dissipation	$P_{tot}$	150	mW

**Kennwerte ( $T_A = 25$  °C,  $\lambda = 870$  nm)****Characteristics**

<b>Bezeichnung</b> <b>Description</b>	<b>Symbol</b> <b>Symbol</b>	<b>Wert</b> <b>Value</b>	<b>Einheit</b> <b>Unit</b>
Fotoempfindlichkeit Spectral sensitivity $V_R = 5$ V, $E_e = 1$ mW/cm <sup>2</sup>	$S$	50 ( $\geq 40$ )	µA
Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit Wavelength of max. sensitivity	$\lambda_{S \max}$	900	nm
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit $S = 10\%$ von $S_{max}$ Spectral range of sensitivity $S = 10\%$ of $S_{max}$	$\lambda$	740 ... 1120	nm
Bestrahlungsempfindliche Fläche Radiant sensitive area	$A$	7	mm <sup>2</sup>
Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Fläche Dimensions of radiant sensitive area	$L \times B$ $L \times W$	2.65 × 2.65	mm × mm
Abstand Chipoberfläche zu Gehäuseober- fläche Distance chip front to case surface	$H$	0.6 ... 0.8	mm
Halbwinkel Half angle	$\phi$	± 65	Grad deg.

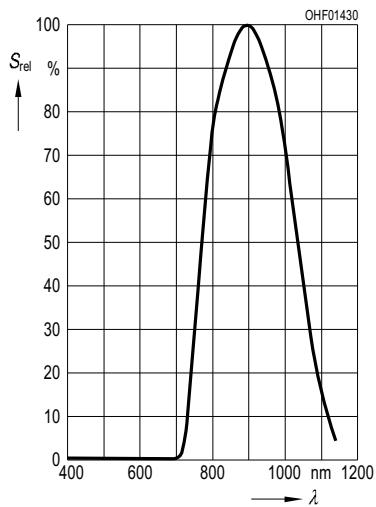
**Kennwerte ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ ,  $\lambda = 870 \text{ nm}$ )**

**Characteristics (cont'd)**

<b>Bezeichnung</b> <b>Description</b>	<b>Symbol</b> <b>Symbol</b>	<b>Wert</b> <b>Value</b>	<b>Einheit</b> <b>Unit</b>
Dunkelstrom, $V_R = 10 \text{ V}$ Dark current	$I_R$	2 ( $\leq 30$ )	nA
Spektrale Fotoempfindlichkeit Spectral sensitivity	$S_\lambda$	0.63	A/W
Quantenausbeute Quantum yield	$\eta$	0.9	Electrons Photon
Leerlaufspannung, $E_e = 0.5 \text{ mW/cm}^2$ Open-circuit voltage	$V_O$	320 ( $\geq 250$ )	mV
Kurzschlußstrom, $E_e = 0.5 \text{ mW/cm}^2$ Short-circuit current	$I_{SC}$	22	μA
Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes Rise and fall time of the photocurrent $R_L = 50 \Omega$ ; $V_R = 5 \text{ V}$ ; $\lambda = 850 \text{ nm}$ ; $I_p = 800 \mu\text{A}$	$t_r, t_f$	20	ns
Durchlaßspannung, $I_F = 100 \text{ mA}$ , $E = 0$ Forward voltage	$V_F$	1.3	V
Kapazität, $V_R = 0 \text{ V}$ , $f = 1 \text{ MHz}$ , $E = 0$ Capacitance	$C_0$	72	pF
Temperaturkoeffizient von $V_O$ Temperature coefficient of $V_O$	$TC_V$	- 2.6	mV/K
Temperaturkoeffizient von $I_{SC}$ Temperature coefficient of $I_{SC}$	$TC_I$	0.03	%/K
Rauschäquivalente Strahlungsleistung Noise equivalent power $V_R = 10 \text{ V}$	$NEP$	$4.0 \times 10^{-14}$	$\frac{\text{W}}{\sqrt{\text{Hz}}}$
Nachweisgrenze, $V_R = 10 \text{ V}$ Detection limit	$D^*$	$6.6 \times 10^{12}$	$\frac{\text{cm} \cdot \sqrt{\text{Hz}}}{\text{W}}$

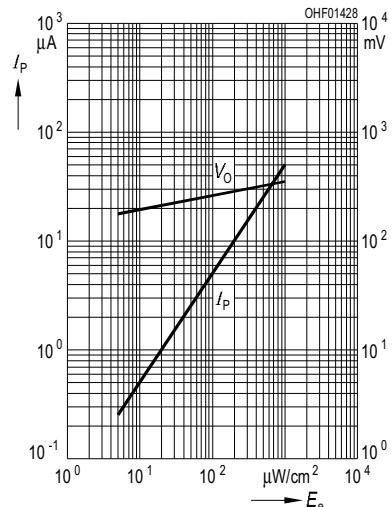
### Relative spectral sensitivity

$$S_{\text{rel}} = f(\lambda)$$



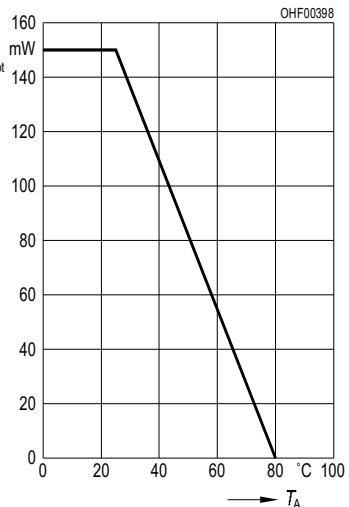
### Photocurrent $I_P = f(E_e)$ , $V_R = 5 \text{ V}$

### Open-circuit voltage $V_O = f(E_e)$



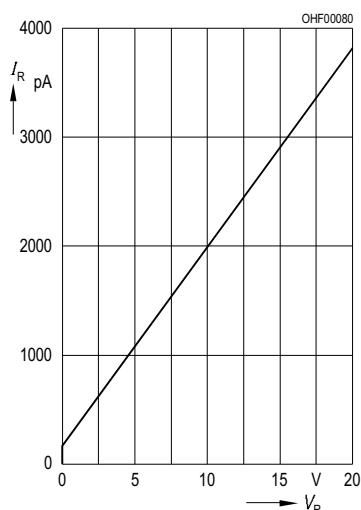
### Total power dissipation

$$P_{\text{tot}} = f(T_A)$$



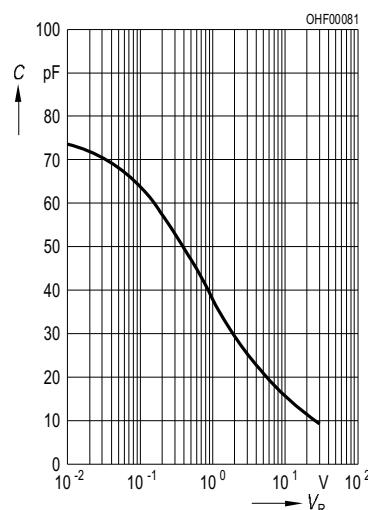
### Dark current

$$I_R = f(V_R), E = 0$$



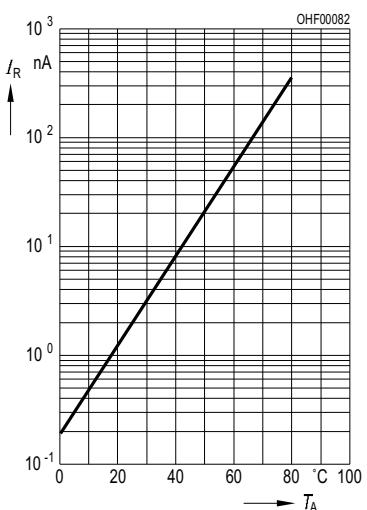
### Capacitance

$$C = f(V_R), f = 1 \text{ MHz}, E = 0$$



### Dark current

$$I_R = f(T_A), V_R = 10 \text{ V}, E = 0$$



### Directional characteristics $S_{\text{rel}} = f(\varphi)$

